

第三代半导体SiC晶体生长及晶圆加工技术 研讨会

随着科学技术的飞速发展，半导体材料的革新速度也进一步加快。当前，碳化硅作为第三代半导体材料的典型代表，在新能源汽车、光伏、储能等新兴领域正快速渗透，已成为全球半导体产业的前沿和制高点。同时，我国“十四五”规划已将碳化硅半导体纳入重点支持领域，碳化硅半导体将在我国5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心等新基建领域发挥重要作用。

近年来，我国在SiC材料领域取得了显著进展，但与国际先进水平相比，在晶体生长技术、晶圆加工技术等方面仍存在一定差距。SiC晶体生长过程中面临着晶体缺陷控制、生长速率提升、晶体质量稳定性等难题；晶圆加工方面，则存在加工精度不足、良品率低、加工成本较高等挑战。在当前倡导节能减排的大趋势下，快速稳定地突破碳化硅单晶尺寸和质量等关键问题，才能够更好地占据未来碳化硅市场。

在此背景下，**中国粉体网**将于**2025年8月21日**在**江苏·苏州**举办**第三代半导体SiC晶体生长及晶圆加工技术研讨会**，大会将汇聚国内行业专家、学者、技术人员、企业界代表围绕晶体生长工艺、关键原材料、生长设备及应用、碳化硅晶片切、磨、抛技术等方面展开演讲交流。

会议时间：

2025 年 8 月 21 日

会议地点：

江苏苏州·白金汉爵大酒店

主办单位：



会议主题：

- 1、碳化硅半导体产业现状与展望
- 2、大尺寸 SiC 晶体生长技术难点及发展现状
- 3、SiC 单晶生长用高纯碳化硅粉体的研究进展
- 4、碳化硅晶体生长装备关键部件应用进展
- 5、碳化硅衬底研磨抛光工艺及耗材技术
- 6、SiC/TaC 涂层技术和应用
- 7、第三代半导体碳化硅的先进切割工艺
- 8、激光技术在碳化硅切割及划片上的应用
- 9、SiC 衬底抛光技术研究
- 10、8 英寸碳化硅外延材料生长核心工艺与关键装备
- 11、碳化硅衬底及外延缺陷检测技术

- 12、碳化硅晶片检测及清洗技术
- 13、SiC 晶体加工关键设备及主要技术难点
- 14、晶圆切割设备市场现状及国产化进程

嘉宾报告：



挑战与机遇并存
——碳化硅材料市场发展现状及展望
王巍 销售副总 / 河北同光半导体股份有限公司

大尺寸激光切片设备
与工艺技术研究
修向前 教授 / 南京大学

题目待定
马康夫 总经理助理 / 山西烁科晶体有限公司

题目待定
李辉 副研究员 / 中国科学院物理研究所

题目待定
陈雪江 副教授 / 西安交通大学能源与动力工程学院

* 更多精彩报告敬请期待

参会对象：

- 高纯碳粉、硅粉、碳化硅粉末、坩埚、籽晶等材料企业；
- 晶锭、衬底、外延、晶圆等产品企业；
- 碳化硅晶体、外延生长等设备企业；
- 金刚石线切割、砂浆线切割、激光切割等切割设备企业；
- 碳化硅磨削、研磨、抛光和清洗及耗材等企业；
- 检测、退火、减薄、沉积、离子注入等其他设备企业；
- 高校、科研院所、行业机构等；

特色活动：

大会征集参会企业相关技术合作、产品采购, 工艺方案等需求进行现场采配活动, 相关信息将进行展板展示, 提高现场沟通交流效率!

征集内容包含但不限于以下几点:

- 1、行业投资、融资需求
- 2、科研成果转化
- 3、产品工艺问题解决方案
- 4、原料、设备、仪器采购需求

大会赞助：

(赞助详细内容请联系会务组了解)

- 1、协办赞助 (含展位、企业致辞, LED 大屏广告, 视频播放, 企业报告等)
- 2、晚宴赞助 (含展位、晚宴大屏 LOGO 展示、晚宴致辞、主持人口播广告等)

3、其它赞助（资料袋、茶歇、椅背广告、胸牌广告赞助等）

4、展位展示（展示桌椅+展位背景墙广告）

会议费用：

付款时间	费用
6月1日前	1800/人
8月1日前	2200/人
8月1日后	2800/人

付款账户：

户名	山东中粉网信息技术有限公司
开户行	中国建设银行股份有限公司临沂沂州支行
帐号	37050182640100001790

会务组：

联系人：段湾湾

联系方式：13810445572（微信）

邮箱：duanwanwan@cnpowder.com



大会组委会 2025年4月